

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年2月5日(05.02.2015)



(10) 国際公開番号
WO 2015/016180 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/312 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01) H01L 21/31 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/069826
- (22) 国際出願日: 2014年7月28日(28.07.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-159667 2013年7月31日(31.07.2013) JP
- (71) 出願人: 株式会社日立国際電気(HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC.) [JP/JP]; 〒1018980 東京都千代田区外神田四丁目1番1号 Tokyo (JP). A Zエレクトロニックマテリアルズマニュファクチャリング株式会社(AZ ELECTRONIC MATERIALS MANUFACTURING (JAPAN) KK) [JP/JP]; 〒1130021 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 奥野 正久(OKUNO Masahisa); 〒9392393 富山県富山市八尾町保内二丁目1番地 株式会社日立国際電気内 Toyama (JP). 角田 徹(KAKUDA Toru); 〒9392393 富山県富山市八尾町保内二丁目1番地 株式会社日立国際電気内 Toyama (JP). 立野 秀人(TATENO Hideto); 〒9392393 富山

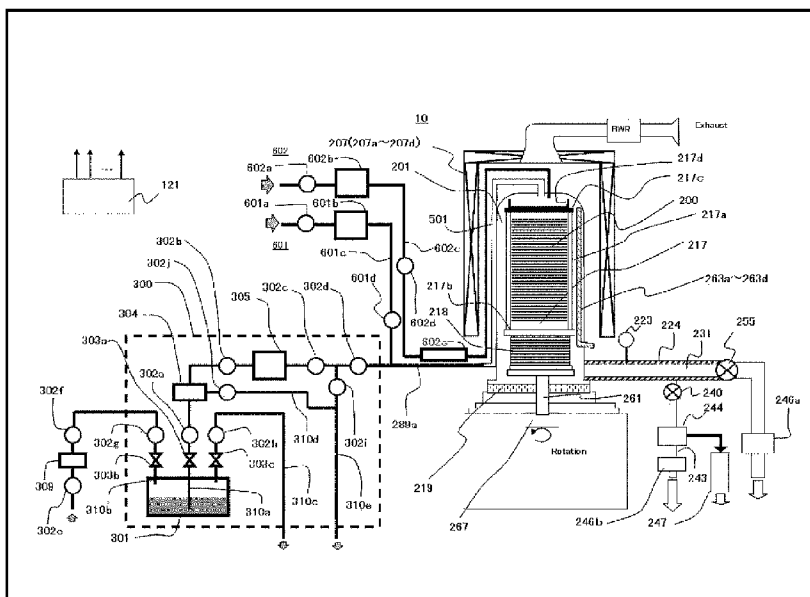
県富山市八尾町保内二丁目1番地 株式会社日立国際電気内 Toyama (JP). 定田 拓也(JODA Takuya); 〒9392393 富山県富山市八尾町保内二丁目1番地 株式会社日立国際電気内 Toyama (JP). 黒川 正路(KUROKAWA Masamichi); 〒4371412 静岡県掛川市千浜3330 AZエレクトロニックマテリアルズマニュファクチャリング株式会社内 Shizuoka (JP).

- (74) 代理人: 油井 透, 外(YUI Tohru et al.); 〒1020072 東京都千代田区飯田橋四丁目6番1号 21東和ビル3F Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ

[続葉有]

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING METHOD, SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS, METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE, AND RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 基板処理方法、基板処理装置、半導体装置の製造方法及び記録媒体



(57) Abstract: This substrate processing method comprises: a step wherein a substrate, which is provided with a prebaked film that has a silazane bond, is carried into a process chamber; a modification step wherein the substrate is heated to a first temperature and a processing gas is supplied to the substrate; and a drying step wherein the substrate is heated at a second temperature that is higher than the first temperature but not higher than the temperature of the prebaking.

(57) 要約: シラザン結合を有する膜が形成され、当該膜にプリベークが施されている基板を処理容器内に搬入する工程と、前記基板を第1温度に加熱して当該基板に処理ガスを供給する改質処理工程と、前記基板を前記第1温度より高く、前記プリベーク時の温度以下の第2温度で加熱する乾燥処理工程と、を有する。

WO 2015/016180 A1



ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))